

г. Караганда, ул. Алиханова 37, офис 108
г. Алматы, ул. Байтурсынова 85, блок Г,
офис 11
г. Астана, проспект Абая, 24/1, офис 47

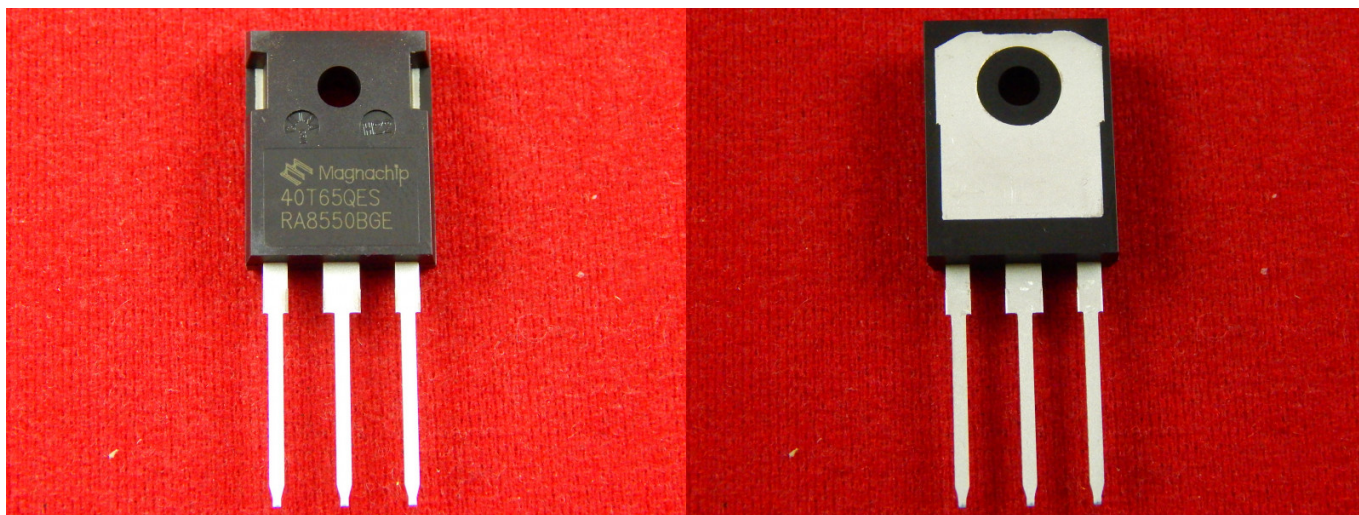
E-Mail: support@radiomart.org



Артикул: 17811

Цена в прайсе: 1078 тг.

MBQ40T65QES, Транзистор IGBT, N-канал, 650В, 80А, ТО-247



Транзистор - полупроводниковый элемент с тремя выводами (обычно), на один из которых (коллектор) подаётся сильный ток, а на другой (база) подаётся слабый (управляющий ток).

IGBT транзистор - это довольно хитроумный прибор, который представляет собой гибрид полевого и биполярного транзистора. Данное сочетание привело к тому, что он унаследовал положительные качества, как полевого транзистора, так и биполярного.

Спецификация:

- Тип транзистора: IGBT;
- Маркировка: 40T65QES;
- Тип управляющего канала: N;
- Максимальная рассеиваемая мощность (Pc), Вт: 230;
- Предельно-допустимое напряжение коллектор-эмиттер |Vce|, В: 650;
- Максимально допустимое напряжение эмиттер-затвор |Vge|, В: 20;
- Максимальный постоянный ток коллектора |Ic| @25°C, А: 80;
- Напряжение насыщения коллектор-эмиттер типовое |VCE(sat)|, В: 1.8;
- Максимальное пороговое напряжение затвор-эмиттер |VGE(th)|, В: 6.5;
- Максимальная температура перехода (Tj), °C: 150;
- Время нарастания типовое (tr), nS: 36;
- Емкость коллектора типовая (Cc), pf: 120;
- Общий заряд затвора (Qg), typ, nC: 60;
- Тип корпуса: TO247.